

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 62067547
PUBLICATION DATE : 27-03-87

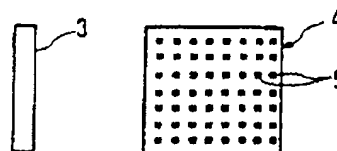
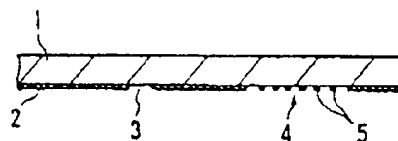
APPLICATION DATE : 20-09-85
APPLICATION NUMBER : 60206664

APPLICANT : HITACHI LTD;

INVENTOR : KAWAMURA YOSHIO;

INT.CL. : G03F 1/00 H01L 21/30

TITLE : PHOTOMASK



ABSTRACT : PURPOSE: To make larger the contrast of light transmitting a fine independent opening pattern close to a resolution limit and to transfer other opening patterns on a wafer at high dimension accuracy by arranging plural fine light shielding patterns on at least one opening pattern.

CONSTITUTION: Plural fine light shielding patterns 5 with dimensions smaller than transfer-enable ones are arranged on the opening pattern 4, do not transfer an image as a pattern, but reduce luminous energy transmitting the opening pattern 4. As a result, the transmissivity of the opening pattern 4 is lower than that of the opening pattern 3. Accordingly, even if an exposure amount is increased, corresponding to the opening pattern 3, the dimensions of the transfer pattern of the opening pattern never become larger. In a photomask for a 1/10 reduction projection exposure device, the dimensions of the light shielding pattern 5 requires only 1-2 μ m, a normal reticule pattern plotting method can easily form the pattern. When the transmissivity is changed in accordance with the dimensions of the opening pattern 4, the arrangement density of the light shield-pattern 5 can be adjusted.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-67547

⑮ Int. Cl.⁴G 03 F 1/00
H 01 L 21/30

識別記号

G C A

庁内整理番号

H-7204-2H
Z-7376-5F

⑬ 公開 昭和62年(1987)3月27日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 ホトマスク

⑯ 特 願 昭60-206664

⑰ 出 願 昭60(1985)9月20日

⑱ 発 明 者 寺 澤 恒 男 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
 ⑱ 発 明 者 森 山 茂 夫 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
 ⑱ 発 明 者 黒 崎 利 栄 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
 ⑱ 発 明 者 河 村 喜 雄 国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内
 ⑲ 出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
 ⑳ 代 理 人 弁理士 中村 純之助

明 細 書

1. 発明の名称 ホトマスク

2. 特許請求の範囲

(1) 透明基板上に遮光膜を設け、その遮光膜を部分的に除去した開口パタンを形成したホトマスクにおいて、上記開口パタンの少なくとも一つに微細な遮光パタンを複数個配置したことを特徴とするホトマスク。

(2) 上記遮光パタンを周期的な開口パタンに配置し、その周期的な開口パタンに一個おきに位相シフト層を設けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のホトマスク。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

この発明は縮小投影露光装置の原画として用いるホトマスクに関するものである。

〔発明の背景〕

第4図(a)は従来のホトマスクの一部を示す断面図である。図において、1はガラス基板、2

はガラス基板1上に設けられたC_r等からなる遮光膜、3、4は遮光膜2を部分的に除去した開口パタンで、開口パタン3は孤立していて、その寸法は縮小投影露光装置の解像限界に近い値であり、また開口パタン4の寸法は比較的大きい。

このようなホトマスクを用いて縮小投影露光装置によりウェハ上にパタンを転写する場合には、ホトマスクを透過する光の強度分布は第4図(b)に示すようになるが、露光光学系が高周波の空間周波数成分を伝達できないため、ウェハ上の強度分布は第4図(c)に示すようになり、開口パタン3を透過した光のコントラストが低くなる。一方、半導体製造工程においては、パタン転写のために所定値以上のコントラストを得る必要がある。このため、開口パタン3を透過した光のコントラストを大きくするために、露光量を多くすることが考えられるが、この場合には開口パタン4に対する露光量が多すぎるため、第4図(d)に示すように開口パタン4の転写パタンの寸法が大きくなってしまふ。

〔発明の目的〕

この発明は上述の問題点を解決するためになされたもので、解像限界に近い微小な孤立開口パターンを透過した光のコントラストを大きくすることができるとともに、その他の開口パターンを高い寸法精度でウェハ上に転写することができるホトマスクを提供することを目的とする。

〔発明の概要〕

この目的を達成するため、この発明においては、透明基板上に遮光膜を設け、その遮光膜を部分的に除去した開口パターンを形成したホトマスクにおいて、上記開口パターンの少なくとも一つに微細な遮光パターンを複数個配置する。

〔発明の実施例〕

第1図はこの発明に係るホトマスクの一部を示す断面図、第2図は第1図に示したホトマスクのパターンを示す図である。図に示すように、開口パターン4には転写可能な寸法より小さい寸法の微細な遮光パターン5が多数個配置されており、遮光パターン5はパターンとして転写することではなく、開口

パターン4を透過する光量を減らす作用を行なう。この結果、開口パターン4の透過率は開口パターン3の透過率より小さくなる。このため、開口パターン3に合わせて露光量を多くしたとしても、開口パターン4の転写パターンの寸法が大きくなることはない。なお、1/10縮小投影露光装置用のホトマスクでは、遮光パターン5の寸法は1~2 μ m程度でよく、通常のレティクルパターン描画法で容易に形成できる。また、開口パターン4の寸法に応じて透過率を変化させたい場合には、遮光パターン5の配置密度を調整すればよい。

ところで、ホトマスク上に周期的な開口パターンが存在するとき、その周期的な開口パターンの一個おきの開口部を透過する照明光の位相を変化させると解像度が向上することが知られており、たとえば露光波長 $\lambda=365\text{nm}$ 、縮小レンズの開口数 $NA=0.4$ である1/10縮小投影露光装置を用いた場合には、ウェハ上で0.6 μ mピッチ（開口部0.3 μ m、遮光部0.3 μ m）の周期的な開口パターンの転写が可能となる。しかし、0.3 μ mの孤立開口パターンと0.3

μ mの周期的な開口パターンとでは適切な露光量が異なり、孤立開口パターンに合わせて露光量を多くすると、周期的な開口パターンの開口部が遮光部より大きく転写され、寸法精度の劣化を招く。そこで、第3図に示すように、照明光の位相を180°変える位相シフト層8を設けた周期的な開口パターン7に微細な遮光パターン5を多数配置して、開口パターン7の透過率を約40%下げ、孤立開口パターン3については何らパターンを設けないようにした。そして、開口パターン3に適切な露光量で露光した結果、周期的な開口パターン7と開口パターン3との両方を精度よく転写することができるようになった。

〔発明の効果〕

以上説明したように、この発明に係るホトマスクにおいては、解像限界に近い微小な孤立開口パターンを透過した光のコントラストを大きくすることができるとともに、その他の開口パターンの転写パターンの寸法精度を向上することができるから、解像限界に近い微小な開口パターンとその他の開口パターンとの両方を寸法精度を劣化させることなく

転写することができる。このように、この発明の効果は顕著である。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明に係るホトマスクの一部を示す断面図、第2図は第1図に示したホトマスクのパターンを示す図、第3図はこの発明に係る他のホトマスクの一部を示す断面図、第4図(a)は従来のホトマスクを示す図、第4図(b)は第4図(a)に示したホトマスク上の強度分布を示すグラフ、第4図(c)、(d)は第4図(a)に示したホトマスクを使用した場合のウェハ上の強度分布を示すグラフである。

- | | |
|------------|----------|
| 1…ガラス基板 | 2…遮光膜 |
| 3、4…開口パターン | 5…遮光パターン |
| 7…開口パターン | 8…位相シフト層 |

代理人弁理士 中村 純之助

図 1

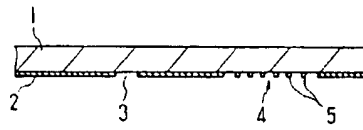


図 2

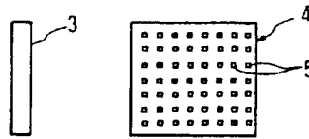


図 3

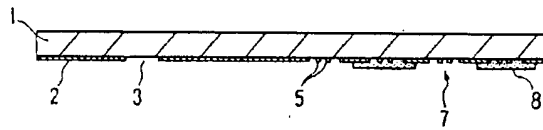


図 4

